

ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID CIRCUITS
COMPOSANTS ACTIFS POUR CIRCUITS HYBRIDES



Silicon NPN transistors, low noise (chip)

Transistors NPN silicium, faible bruit (pastille)

Type Type	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	h_{21E} / V_{CE} (V)		I_C (mA)	F (dB)
				min - max			
J.2N 930	45	45	30	100 - 300	5	0,010	3
J.2N 2483	60	60	50	40 - 120	5	0,010	4
J.2N 2484	60	60	50	100 - 500	5	0,010	3

Silicon NPN transistors, fast switching (ship)

Transistors NPN silicium, commutation rapide (pastille)

Type Type	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	h_{21E} / V_{CE} (V)		I_C (mA)
		V_{CER}^*		min - max		
J.2N 706	25	20*		20*	1	10
J.2N 706 A	25	15		20 - 60*	1	10
J.2N 708	40	15		30 - 120*	1	10
J.2N 2369	40	15	200	40 - 120*	1	10

Silicon PNP transistors, fast switching (chip)

Transistors PNP silicium, commutation rapide (pastille)

Type Type	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	h_{21E} / V_{CE} (V)		I_C (mA)
				min - max		
J.2N 2894	-12	-12	-200	40 - 150*	-0,5	-30

* Pulsed
Impulsions